

**У27 Исупова Г.Г.**  
асп., Нижегородский ГУ

Открытые квантовые билиарды со спин-орбитальным взаимодействием: влияние магнитного поля на резонансные особенности проводимости

#### ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 6 (27 ноября 14<sup>00</sup> – 15<sup>15</sup>)

**У28 Василенко М.А.**  
студ., Новосибирский ГТУ

Монте-Карло моделирование самокаталитического роста нитевидных кристаллов GaAs

**У29 Чубанов А.А.**  
асп., Нижегородский ГУ

Краевые состояния и проводимость в топологическом изоляторе висмут на кремнии

**У30 Синцова К.А.**  
студ., СПбГПУ, С.-Петербург

Влияние латеральной делокализации носителей в квантовых ямах InGaN/GaN на эффективность светодиодов при высоких уровнях инжекции

**У31 Дмитриев Г.С.**  
асп., ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН,  
С.-Петербург

Влияние одноосной деформации на магнитооптические свойства ферромагнитного полупроводника (Ga,Mn)As

**У32 Котова М.С.**  
студ., МГУ, Москва

Эффект резистивного переключения в органических материалах на микромасштабах и энерго-независимая память на его основе

#### ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 7 (27 ноября 15<sup>30</sup> – 17<sup>00</sup>)

**У33 Румянцев В.В.**  
асп., ИФМ РАН, Нижний Новгород

Длинноволновая ИК фотолюминесценция и фото-проводимость в узкозонных твердых растворах  $Hg_{1-x}Cd_xTe$  и КЯ  $Hg_{1-x}Cd_xTe/Cd_yHg_{1-y}Te$

**У34 Аслаяни А.Э.**  
студ., МГУ, Москва

Электроотражение от множественных квантовых ям InGaN, помещенных в неоднородное электрическое поле p-n-перехода

**У35 Лазаренко А.А.**  
асп., Академический университет  
РАН, С.-Петербург

Молекулярно-пучковая эпитаксия азотосодержащих твердых растворов GaPN, GaPNAs и InGaPN

**У36 Милахин Д.С.**  
студ., Новосибирский ГТУ

Физико-химические процессы при взаимодействии  $NH_3$  с поверхностью (0001)  $Al_2O_3$

**У37 Пашенко В.П.**  
асп., СПбГПУ, С.-Петербург

Формирование индуцированной электрическим полем акустической сверхрешетки в сегнетоэлектрической тонкой пленке